

応用物理学会関西支部セミナー「半導体ナノデバイスの展開」

日 時 : 2008 年 3 月 31 日 (月) 14:40 - 16:40

場 所 : 大阪大学電気系 1 階 E6-111

吹田市山田丘 2-1 阪大吹田キャンパス内

阪急北千里駅より東へ徒歩 20 分

詳細は以下を参照して下さい

<http://www.osaka-u.ac.jp/jp/accessmap.html>

主 催 : 応用物理学会関西支部

協 賛 : 大阪大学グローバル COE プログラム

「次世代電子デバイス教育研究開発拠点」

参加費 : 無料

内 容 : モンテカルロ法を用いた半導体デバイスシミュレーションについて、基本的なことからはじめて、GaN のフルバンドモンテカルロシミュレータを例に詳しく紹介します。

プログラム

14:40 - 15:20 “モンテカルロシミュレーションの基礎”

森 伸也 (大阪大学)

15:20 - 15:30 - 休憩 -

15:30 - 16:40 “GaN フルバンドモンテカルロシミュレーションとデバイスモデリングへの応用”

山川 真弥 (ソニー)

問合わせ先 : 森 伸也 (阪大工電子)

TEL 06-6879-7766, FAX 06-6879-7753

E-mail: nobuya.mori@eei.eng.osaka-u.ac.jp

本セミナーの前に、世界最大のパワーデバイスメーカーであるインフィニオンの上席研究員である Leo Lorenz 博士の最新のパワーデバイス研究開発動向に関する講演会が予定されております。あわせてご出席くださるようご案内申し上げます (詳細につきましては下記 web ページをご覧ください)。 http://www.eei.eng.osaka-u.ac.jp/gcoe/seminar/pdf_2007/Gs_Power_p.pdf